

大見研究室 和文 論文リスト

1988 年

- 70-1(P) 大見忠弘、竹浪敏人、室田淳一、御子柴宣夫、坪内和夫、益一哉、「スーパークリーンルームの省エネルギー設計と省エネルギー運転」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.1-51、1988年1月。
- 71-1(P) 安田正志、竹浪敏人、大見忠弘、「微振動計測と振動対策」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.53-87、1988年1月。
- 72-1(P) 大見忠弘、室田淳一、「クリーンボンベとガス充填技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.107-128、1988年1月。
- 73-1(P) 菅野洋一、都田昌之、大見忠弘、「高速置換特性を有するガス配管系」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.129-159、1988年1月。
- 74-1(P) 阿部光夫、杉山和彦、大見忠弘、宮野安定、箭原繁雄、「パラジウム膜水素純化装置」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.161-192、1988年1月。
- 75-1(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーが可能にする新しいプロセス技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.193-211、1988年1月。
- 76-1(P) 室田淳一、中村直人、加藤学、御子柴宣夫、大見忠弘、「高選択性を有するウルトラクリーンCVD技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.213-226、1988年1月。
- 77-1(P) 森田瑞穂、光地哲伸、大見忠弘、熊谷浩洋、伊藤雅樹、「自由分子流照射型低温高速CVD技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.227-243、1988年1月。
- 78-1(P) 杉山和彦、中原文生、奥村毅、大見忠弘、室田淳一、「アウトガスフリー耐腐食性ステンレス表面処理技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.6、高性能化プロセス技術Ⅲ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.245-263、1988年1月。
- 79(P) 松戸清彦、大見忠弘、柴田直、市川武史、岩淵浩志、「Low-Kinetic-Energy Particle Process によるSi薄膜の形成」、応用物理学会・応用電子物性分科会研究報告(No.422)、pp.19-24、1988年1月。
- 80(P) 斉藤達之、大見忠弘、柴田直、桑原英司、「Low-Kinetic-Energy Particle Process によるCu薄膜の形成」、応用物理学会・応用電子物性分科会研究報告(No.422)、pp.25-30、1988年1月。
- 81-1(M) 大見忠弘、竹浪敏人、室田淳一、御子柴宣夫、坪内和夫、益一哉、「ppt への挑戦—運転コストを 1/2 に減らすクリーンルームの設計技術」、日経マイクロデバイス 1988年2月号、No.32、(日経マグロウヒル社)、pp.94-103、1988年2月。
- 82(M) 大見忠弘、平塚豊、藤崎芳男、野田正人、「薬液槽エアシール方式クリーンドラフトと省エネルギー効果」、日立評論 1988.2.Vol.70、(日立製作所)、1988年2月。
- 83(F) 大見忠弘、御子柴宣夫、坪内和夫、「究極のクリーンルーム、極限微細化電子回路の実現を目指して」、空気調和・衛生工学、第62巻 第3号、((社)空気調和衛生工学会)、pp.169-178、1988年3月。
- 84(M) 大見忠弘、「0.5 μ m ULSIテクノロジー」、総説、((社)電子情報通信学会)、pp.1-14、1988年3月。

- 85(P) 大見忠弘、御子柴宣夫、「クリーンルームの現状と将来」、化学工学協会第 53 年会研究発表講演要旨集((社)化学工学協会)、1988 年 3 月。
- 86(M) 大見忠弘、「技術開発への“熱き心”を語る」、マイテクノミヤギ・2、(テクノ財団)、pp.19、1988 年 3 月。
- 87(F) 大見忠弘、「超LSI製造における Ultra Clean Technology とインプロセス計測」、精密工学会誌 Vol.54、No.4、pp627-632、1988 年 4 月。
- 88(P) 柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射による表面クリーニングと低温高品質成膜技術」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号-88-2、pp.3-8、1988 年 4 月。
- 89(B) 増田清隆、柴田直、大見忠弘、「クリーンルーム用無塵紙からの発塵の評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSI製造におけるトータルクリーン化技術、(リアライズ社)、pp.249-258、1988 年 4 月。
- 90-1(M) 大見忠弘、三島博之、水庭哲夫、阿部光夫、安井富春、「ppt への挑戦—パーティクルを 1/10 に抑えるウェット洗浄」、日経マイクロデバイス 1988 年 5 月号、No.35、(日経マグロウヒル社)、pp.98-103、1988 年 5 月。
- 91(P) 桑原英司、大見忠弘、斉藤悟、柴田直、「低エネルギーイオン照射プロセスによる純アルミニウムULSI配線技術」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号SDM88-34、pp.23-28、1988 年 6 月。
- 92(P) 斉藤達之、大見忠弘、柴田直、新田雄久、「低エネルギーイオン照射プロセスによるCu・ULSI配線技術」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号SDM88-35、pp.29-34、1988 年 6 月。
- 93-1(P) 竹浪敏人、大見忠弘、福田宗治、「省エネルギー型空調除塵システム」、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.1-28、1988 年 7 月。
- 94-1(P) 水庭哲夫、矢部江一、後藤幸雄、大見忠弘、「超純水システム」、大見、新田監修半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.29-50、1988 年 7 月。
- 95-1(P) 中原文生、杉山和彦、佐藤剛士、大見忠弘、「プロセス用ガス配管システムの設計論」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.51-77、1988 年 7 月。
- 96-1(P) 柄崎英夫、東川智信、島村孝、菅田佳寿、大見忠弘、杉山和彦、「無発塵空圧計装システム」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.97-135、1988 年 7 月。
- 97-1(P) 宮下雅之、川辺一郎、丸橋一夫、石田隆史、菊山裕久、前野又五郎、三木正博、室田淳一、大見忠弘、「ウェハドライ洗浄 フッ化不働態処理」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.171-207、1988 年 7 月。
- 98-1(P) 柴田直、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射成膜技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.229-241、1988 年 7 月。
- 99-1(P) 今井茂、石原良夫、丁剛珠、大見忠弘、「自己整合加熱によるプロセスの低温化」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.243-263、1988 年 7 月。
- 100-1(P) 大見忠弘、「プロセス完全自動化への方向」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.7、サブミクロンULSIプロセス技術、プロシーディング(別冊)、(リアライズ社)、pp.1-31、1988 年 7 月。

- 101-1(M) 大見忠弘、杉山和彦、中原文生、都田昌之、菅野洋一、大長則雄、「ppt への挑戦—ページ後の残留ガス抑制はバルブ内の滞留部除去で解決」、日経マイクロデバイス 1988 年 7 月号、No.37、(日経BP社)、pp.126-130、1988 年 7 月。
- 102-1(M) 大見忠弘、「ppt への挑戦—配管内で不純物をどこまで許容できるか、定量化にメド」、日経マイクロデバイス 1988 年 8 月号、No.38、(日経BP社)、pp.98-104、1988 年 8 月。
- 103(P) 市川武史、大見忠弘、柴田直、岩淵浩志、「低エネルギーイオン照射によるシリコンの低温エピタキシャル成長(1. 結晶性評価)」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 88-52、pp.37-42、1988 年 8 月。
- 104(P) 岩淵浩志、大見忠弘、柴田直、市川武史、「低エネルギーイオン照射によるシリコンの低温エピタキシャル成長(2. 電気的特性の評価)」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM88-53、pp.43-46、1988 年 8 月。
- 105(P) 石原良夫、大見忠弘、柴田直、沖田彰、「高濃度イオン注入層の低温アニール」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM88-56、pp.13-18、1988 年 8 月。
- 106(M) 大見忠弘、「クリーン化技術とその周辺」、トリプルA、(三菱電機株)、pp.2-3、1988 年 9 月。
- 107(P) 大見忠弘、稲葉仁、竹浪敏人、御子柴宣夫、「スーパークリーンルーム技術」、電気学会研究会資料、(電子デバイス・半導体電力変換合同研究会)、論文番号 EDD-88-51・SPC-88-49、pp.17-26、1988 年 10 月。
- 108(P) 大見忠弘、柴田直、「超高清浄化技術によるULSIプロセスの低温化」、応用物理学学会学術講演会、低温プロセスシンポジウム、1988 年 10 月。
- 109(M) 大見忠弘、「半導体の視点から洗い直し、超クリーン化技術を構築」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.32-38、1988 年 10 月。
- 54-2(M) 大見忠弘、「不純物濃度 ppt に挑戦する半導体用ガス配管システムの構築」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.40-61、1988 年 10 月。
- 102-2(M) 大見忠弘、「配管内で不純物をどこまで許容できるか定量化にメド」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.62-68、1988 年 10 月。
- 61-2(M) 大見忠弘、石原良夫、森田瑞穂、「検出限界 2×10^{-11} Torr \cdot l/秒を確認、外部からの不純物混入を防ぐ」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.82-90、1988 年 10 月。
- 62-2(M) 大見忠弘、杉山和彦、「現状の検出限界はまだ数百 ppb、鏡面冷却方式の開発が急務」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.94-102、1988 年 10 月。
- 64-2(M) 大見忠弘、杉山和彦、中原文生、奥村毅、菅野洋一、津田格、「パーティクルをゼロ・レベルに抑え、吸着した水分の素早い排除も可能に」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.104-112、1988 年 10 月。
- 101-2(M) 大見忠弘、杉山和彦、中原文生、都田昌之、菅野洋一、大長則雄、「滞留部を完全除去、しかもガスの切り替えを高速化」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.113-117、1988 年 10 月。
- 110(M) 大見忠弘、水口泰光、杉山和彦、菅野洋一、八木沢茂、「ガス供給系施工後の立ち上げをわずか 24 時間に短縮」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.118-121、1988 年 10 月。
- 111(M) 三平博、佐藤清志、大見忠弘、杉山和彦、中原文生、「20cc/分以下の少流量用で 1l/分大量にページ」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.122-125、1988 年 10 月。
- 112(M) 大見忠弘、室田淳一、「特殊ガス中の水分濃度をユース・ポイントで 10ppb 以下に」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.126-129、1988 年 10 月。

- 113(M) 柄崎英夫、大見忠弘、杉山和彦、菅野洋一、「200℃のベーキングを実現、濃度を 5ppb 以下に低減」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.130-133、1988年10月。
- 114(M) 大見忠弘、杉山和彦、阿部光夫、辻本光志、宮野安定、箭原繁雄、児山豊、「最後の課題、CH₄濃度を 10ppt 以下に」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.134-135、1988年10月。
- 115(M) 大見忠弘、中原文生、杉山和彦、「滞留部を完全に除去、ppt の不純物レベル達成を可能に」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.136-141、1988年10月。
- 116(M) 丸山一仁、大見忠弘、杉山和彦、「配管側壁に圧力検出部を合体、減圧弁はパーティクル発生要因を排除」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.142-144、1988年10月。
- 117(M) 大見忠弘、菅野洋一、前畑英彦、馬場吉康、「凹凸 0.1 μm以下で鏡面仕上げ、パーティクルの発生を防止」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.146-149、1988年10月。
- 118(M) 大見忠弘、杉山和彦、奥村毅、室田淳一、菅野洋一、「塩素ガスに耐え、わずか数時間で 2.5ppb に水分が減る表面を実現」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.150-153、1988年10月。
- 119(M) 溝上敏、国本温、大見忠弘、杉山和彦、「不純物濃度を数 ppb まで下げた原料ガスが供給可能に」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.154-158、1988年10月。
- 81-2(M) 大見忠弘、竹浪敏人、室田淳一、御子柴宣夫、坪内和夫、益一哉、「運転コストを 50%に減らす設計思想」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.160-169、1988年10月。
- 120(M) 大見忠弘、竹浪敏人、室田淳一、御子柴宣夫、坪内和夫、益一哉、福田宗治、「空調機の効率アップで、さらに運転コストを 40%に削減する」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.170-175、1988年10月。
- 121(M) 大見忠弘、柴田直、「ウェーハを大気にさらさないプロセス・ラインを提案」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.182-190、1988年10月。
- 90-2(M) 大見忠弘、三島博之、水庭哲夫、阿部光夫、安井富春、「高純度薬品、超純水、蒸気乾燥を駆使、パーティクルを 1/10 に抑制」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.196-201、1988年10月。
- 122(M) 宮下雅之、川辺一郎、丸橋一夫、石田隆史、菊山裕久、前野又五郎、三木正博、大見忠弘、室田淳一、「濃度を抑えた HF ガスで自然酸化膜を選択エッチング」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.202-207、1988年10月。
- 123(M) 室田淳一、御子柴宣夫、大見忠弘、「雰囲気とウェーハ表面をクリーン化、650℃の低温でSiをエピ成長」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.208-215、1988年10月。
- 124(M) 大見忠弘、柴田直、「イオン照射で清浄化、成膜を制御、350℃でSiをエピ成長」、日経マイクロデバイス別冊 No.2、ppt への挑戦 超クリーン化技術、(日経BP社)、pp.216-224、1988年10月。
- 125-1(M) 大見忠弘、「特集 半導体の不純物精密制御とクリーン化 1 ULSI を実現するウルトラクリーンプロセス」、電気化学および工業物理化学、((社)電気化学協会)、pp.916-920、1998年11月。
- 125-2(P) 大見忠弘、「日本の科学・技術のどこが弱いのか」、昭和 63 年度計量研究所研究講演会資料、新時代に対応した計測技術の発展、((財)日本産業技術振興協会)、pp.45-50、1988年11月。